Параметри виготовлення зразків

Зразок	Розчин,	ω, об/хв	t _d , xB	У3	Площа,	Примітка
	%	•			MM^2	
61a	3-4	3000	20	mo.14	7	Vpp=9.5 V
61c	3-4	3000	20	так	17	
62a					16.5	Перед відпалом
62b	3-4	3000	20	ні	4.=	знаходився в
					17	акустичному контакті (гель) з перетворювачем
(2)					1.7	(тель) з перетворювачем
63a	3-4	3000	20		17	
63b	3-4	3000	20	H1	17.5	
64a	2.4	2000	20	more.	12	Vpp=5 V
64b	3-4	3000	20	так	17.5	

Висота бар'єру по CV-характеристикам

Зразок	Висота бар'єру, еВ					
	1 МГц	100 кГц	10 кГц	Імпедансна спектроскопія		
61a	0.81	0.69	0.66			
61c	0.83	0.69	0.66			
62a	0.81	0.66	0.63			
62b	0.74	0.62	0.59			
63a	0.99	0.68	0.65			
63b	0.87	0.69	0.66			
64a	0.89	0.70	0.66			
64b	0.90	0.67	0.64			

Прямі вольт-амперні характеристики, виміряні при Т=297 К, апроксимувалися відповідно до одно- або дво-діодної моделі:

$$J = J_0 \left\{ \exp \left[\frac{q \left(V - JR_s \right)}{nkT} \right] - 1 \right\} + \frac{V - JR_s}{R_{sh}}$$

$$J = J_{01} \left\{ \exp \left[\frac{q(V - JR_s)}{n_1 kT} \right] - 1 \right\} + J_{02} \left\{ \exp \left[\frac{q(V - JR_s)}{n_2 kT} \right] - 1 \right\} + \frac{V - JR_s}{R_{sh}}$$

Зразок	J_0 , A/M ²	n	Rs, Om m ²	Rsh, Om m ²
61a	4e-8	1	9e-4	0.5
	0.1	3.8		
61c	2.9e-8	1	9e-4	2.1
	0.007	2.68		
62a	0.04	1.56	3e-3	багато
62b	1.9e-8	1	9e-4	багато
	0.003	2.45		
63a	1.5e-8	1	6e-4	13
	0.003	2.4		
63b	2.6e-8	1	1e-3	багато
	0.008	2.85		
64a	0.02	2.17	4e-3	багато
64b	1.8e-8	1	8e-4	4.2
	0.013	2.94		

Зворотні ВАХ:

